

Si-MOS-Feldeffekttransistoren (p-Kanal-Anreicherungstyp)

Кремниевые полевые транзисторы МОП (обогащающий тип с p-каналом)

Typ Тип	Grenzdaten bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$ Предельные значения при					Informationsdaten bei $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$ Информационные данные при							
	P_{tot}	U_{DS} U_{DB}	U_{GS} U_{GB}	U_{DG}	U_{SB}	$-I_{\text{D}}$ I_{DRM}^*	$-I_{\text{D}}$	Y_{21}	bei при $-U_{\text{DS}}$	$-U_{\text{T}}$	bei при $-I_{\text{D}}$	C_{ges}	R_{DS}
	mW	V	V	V	V	mA	mA	mS	V	V	μA	pF	Ω
SMY 50	225	— 31/+ 0,3	— 31/+ 0,3	± 31	— 15/+ 0,3	25	10	2	10	3...6	10	<12	150
SMY 51 ¹⁾	240	— 31/+ 0,3	— 31/+ 0,3	± 31	0	20	12	2	10	3...6	10	<12	150
SMY 52	300	— 31/+ 0,3	— 31/+ 0,3	± 31	— 15/+ 0,3	60	50	12,5	10	3...6	10	<38	35
SMY 60 ³⁾	240	— 25/+ 0,3	— 25/+ 0,3	± 25	— 15/+ 0,3	120*				>2,8	10	<10	
U 105 D ²⁾	400	— 31/+ 0,3	— 31/+ 0,3	± 31	0	25	>3		2	3...6	10	<12	150

¹⁾ Doppeltransistor

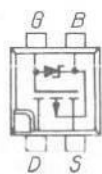
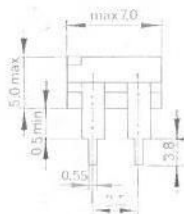
²⁾ 6-fach-Transistor (MOS-Schaltkreis)

³⁾ Doppeltransistor ohne Gateschutzdioden, getrennter Substratanschluß

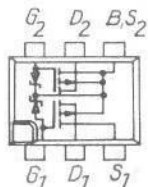
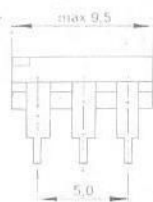
¹⁾ Двойной транзистор

²⁾ Шестикратный транзистор (интегральная схема МОП)

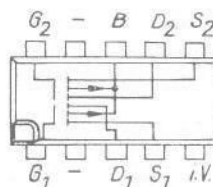
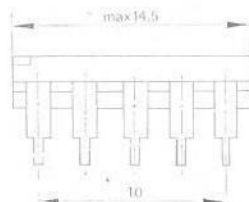
³⁾ Двойной транзистор без защитных диодов и отдельным выводом для подложки.



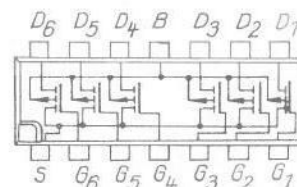
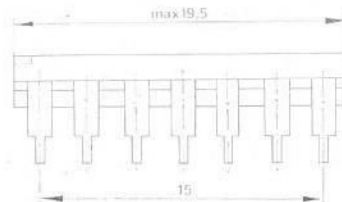
SMY 50
SMY 52



SMY 51



SMY 60



U 105 D



MOD 11.6